

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-226075

(43) 公開日 平成4年(1992) 8月14日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 29/44	B	7738-4M		
21/285	3 0 1 L	7738-4M		
27/092				
		7342-4M	H 0 1 L 27/08	3 2 1 F
		8422-4M	29/78	3 0 1 Z
審査請求 未請求 請求項の数11(全 18 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平3-129771

(22) 出願日 平成3年(1991) 5月31日

(31) 優先権主張番号 特願平2-139618

(32) 優先日 平2(1990) 5月31日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願平2-208145

(32) 優先日 平2(1990) 8月8日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 大岡 逸男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(72) 発明者 光地 哲伸

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 平面的に余分な面積を必要とせず、必要最小限の構成要素のみで形成することができ、レイアウト面積を大幅に縮小することができ、微細加工および高集積化に適し、微細な機能素子を有する半導体装置を提供する。

【構成】 第1導電型の第1半導体（例えば、P-ウェル）と、この第1半導体領域上または下に設けられ、前記第1導電型とは異なる第2導電型の第2半導体領域（例えばソースまたはドレイン領域）と、を有し、前記第1半導体領域に電氣的に接続される電極が、前記第2半導体領域を通じて形成されており、前記第1半導体領域と前記第2半導体領域とが前記電極によって短縮されていることを特徴とする。

